УДК 538.69:541.141.1

ФИЗИЧЕСКАЯ ХИМИЯ

С. И. КУБАРЕВ, Е. А. ПШЕНИЧНОВ, А. С. ШУСТОВ

**ВЛИЯНИЕ МАГНИТНОГО ПОЛЯ НА СКОРОСТЬ ФОТООКИСЛЕНИЯ
НЕКОТОРЫХ КРИСТАЛЛИЧЕСКИХ АРОМАТИЧЕСКИХ
УГЛЕВОДОРОДОВ**

(Представлено академиком В. Н. Кондратьевым 8 XII 1971)

В данной работе предлагается объяснение нового эффекта, состоящего во влиянии магнитного поля на скорость реакции фотоокисления при обычной температуре, обнаруженного недавно Франкевичем и Соколикотом (1). Хотя этот эффект наблюдался только для тетрацена, по-видимому, его можно ожидать и для некоторых других ароматических углеводородов. Согласно последним экспериментальным данным (2), первой стадией фотоокисления ароматического углеводорода служит перенос энергии от триплетно-возбужденной молекулы к молекуле кислорода с образованием синглетно-возбужденного состояния $O_2(^1\Delta_g$ или $^1\Sigma_g^+$). Впервые предположение о фундаментальной роли синглетного кислорода в реакциях фотоокисления было высказано Каутским (см., например, (3)). Предлагается следующая схема реакции:

где 3A и 1A_0 — триплетный экситон ароматического углеводорода и его основное состояние соответственно; $(^3A^3O_2)$ — столкновительный комплекс, 1O_2 — синглетно-возбужденный кислород, C — первичный продукт фотоокисления.

В работе (1) измерялась скорость накопления C , концентрация которого, как мы полагаем, пропорциональна концентрации 1O_2 . Для начальной стадии реакции (1) каналами убыли 1O_2 можно пренебречь. Тогда схема реакции упрощается:

Реакция (2) представляет триплет-триплетную аннигиляцию, возникающую вследствие обменно-резонансного взаимодействия (4). Именно эта аннигиляция и является магниточувствительной, поскольку константа скорости образования синглетных частиц из n -го спинового состояния комплекса $(^3A^3O_2)$ по обменно-резонансному механизму пропорциональна величине $|S_n|^2$, где S_n — проекция n -го состояния на синглетное состояние комплекса. S_n , в свою очередь, зависит от магнитного поля. Спин-гамильтонова системы $(^3A^3O_2)$ имеет вид

$$\hat{\mathcal{H}} = g_1 \beta \mathbf{H} \hat{S}_1 + \hat{S}_1 \hat{D}_1 \hat{S}_1 + g_2 \beta \mathbf{H} \hat{S}_2 + D_2 (\hat{S}_{2z}^2 - 2/3). \quad (3)$$

Здесь $\mathbf{H}$ — магнитное поле, $\hat{D}_1$ и $\hat{D}_2$ — тензоры расщепления в нулевом поле. Индексы 1 и 2 относятся к ароматическому углеводороду и кислороду соответственно. Ось z направлена вдоль оси O_2 .

Из сказанного следует, что при расчете γ -эффективной константы скорости образования 1O_2 как функции от $\mathbf{H}$, может быть использована кинетическая схема, предложенная в работе (5).

В случае, когда все спиновые уровни комплекса не вырождены и расстояния между ними много больше их ширины, согласно (5), имеем

$$\gamma = \frac{1}{9} k_1 k \sum_{n=1}^9 \frac{|S_n|^2}{1 + k |S_n|^2}; \quad k = \frac{k_s}{k_{-1}}. \quad (4)$$

Если какие-либо два спиновых уровня (например, уровни $n = 1$ и $n = 2$) близки между собой, то выражение для γ по аналогии с (5) примет вид:

$$\gamma = \gamma_{1,2}(\omega) + \frac{1}{9} k_1 k \sum_{n=3}^9 \frac{|S_n|^2}{1 + k |S_n|^2}, \quad (5)$$

где

$$\begin{aligned} \gamma_{1,2}(\omega) &= \gamma_{1,2}(\infty) - \frac{\gamma_{1,2}(\infty) - \gamma_{1,2}(0)}{1 + \omega^2/\Delta^2}, & \gamma_{1,2}(\infty) &= \frac{1}{9} k_1 k \sum_{n=1}^2 \frac{|S_n|^2}{1 + k |S_n|^2}, \\ \gamma_{1,2}(0) &= \frac{1}{9} k_1 k \frac{|S_1|^2 + |S_2|^2}{1 + k (|S_1|^2 + |S_2|^2)}; \\ \omega &= \frac{E_1 - E_2}{k_{-1}}, & \Delta^2 &= \frac{[1 + k (|S_1|^2 + |S_2|^2)] [1 + k/2 (|S_1|^2 + |S_2|^2)]^2}{(1 + k |S_1|^2) (1 + k |S_2|^2)}. \end{aligned}$$

Из (5) видно, что влияние магнитного поля на величину γ максимально при $k \gg 1$ и исчезает при $k \rightarrow 0$. С другой стороны, магнитное поле может влиять на величину γ , только если время спин-решеточной релаксации $T > (k_{-1})^{-1}$.

Расчеты, приведенные ниже, проводились на примере антрацена. По оценкам (6), в антраcene $T \sim 10^{-8}$ сек., поэтому эффект может наблюдаться, если $k_{-1} \geq 10^8$ сек $^{-1}$. Согласно работе (7), главные значения тензора расщепления в нулевом поле для триплетного экситона в антраcene равны: $X_1 \simeq -370$, $Y_1 \simeq 330$, $Z_1 - 40$ э; $g_1 = 2,00$ и для кислорода $D_2 \simeq 30$ кэ при $g_2 = 2,00$ (8). Такое большое различие величин расщеплений в нулевом поле для антрацена и кислорода позволяет выделить три интервала величин H , для которых при нахождении собственных векторов и энергий оператора (3) применима теория возмущений:

- а) малые поля $0 \leq H < 10^2$ э;
- б) промежуточные поля 10^2 э $< H < 10^4$ э;
- в) большие поля $H > 10^5$ э.

Можно предполагать, что эффективность передачи энергии по обменно-резонансному механизму сильно зависит от взаимной ориентации донора и акцептора энергии (9). Различный выбор ориентации оси O_2 по отношению к осям тензора $\hat{D}_1$ несущественно меняет качественную картину зависимости $\gamma(H)$, но влияет на анизотропию константы γ как функции от H . Расчеты проведены при ориентации оси O_2 вдоль короткой оси молекулы антрацена. Ниже приведены основные результаты этих расчетов.

В случае а) γ медленно растет с увеличением магнитного поля, так как при $H = 0$ шесть из девяти спиновых уровней попарно вырождены, а при $H \neq 0$ вырождение снимается.

В случае б) γ существенно зависит от направления H , причем его анизотропия определяется положением O_2 в кристалле, так как $X_1, Y_1, Z_1 \ll D_2$.

Рис. 1. График анизотропии эффективной константы скорости $\gamma(H)$ при H , лежащем в плоскости ab . Напряженность магнитного поля соответствует случаю б), $k = 10^2$ и $k_{-1} = 10^8$ сек $^{-1}$. За единицу масштаба принята величина $(1/9)k_1$.

Поскольку в элементарной ячейке кристалла антрацена содержится две молекулы, то каждой из двух возможных ориентаций O_2 соответствует свое значение γ_i ($i = 1, 2$). При комнатных температурах экспериментально наблюдаемое значение γ равно $\gamma = (1/2)(\gamma_1 + \gamma_2)$.

Зависимость $\gamma(H)$ при H , лежащем в плоскости ab кристалла, приведена на рис. 1. Сравнение теории с опытом позволяет оценить величину k . Отношение $\gamma(H)/\gamma(O) = \xi$, вычисленное при помощи (4) и (5), дает:

$$\begin{aligned} k = 1, \quad \xi &= 1,1 (+10\%); \\ k = 10, \quad \xi &= 1,5 (+50\%); \\ k = 10^2, \quad \xi &= 1,7 (+70\%). \end{aligned}$$

При некоторых направлениях поля H значение ξ будет меньше указанных выше, вследствие пересечения спиновых уровней комплекса ($^3A^3O_2$).

В случае в) γ практически не зависит от H , когда три уровня, содержащие ненулевые синглетные компоненты, не пересекаются. При их пересечении γ будет несколько меньше. Величина ξ зависит от разности g -факторов антрацена и O_2 . Например, при $(g_1 - g_2) \sim 10^{-3}$ находим:

$$\begin{aligned} k = 1, \quad \xi &= 0,9 (-10\%); \\ k = 10, \quad \xi &= 0,75 (-25\%); \\ k = 10^2, \quad \xi &= 0,6 (-40\%). \end{aligned}$$

Приведенные результаты получены для монокристалла. Для поликристаллического образца величину эффективной константы скорости $\tilde{\gamma}$ можно найти, усреднив $\gamma(H)$ по направлениям H . График $\tilde{\gamma}(H)$ для поликристалла представлен на рис. 2.

Рис. 2. График зависимости $\tilde{\gamma}(H)$ для поликристалла (при $k = 10^2$). Сплошной линией изображены рассчитанные участки кривой, пунктиром указано предполагаемое поведение зависимости

Следует отметить, что если ориентация O_2 относительно молекулы ароматического углеводорода не совпадает с рассмотренной, то анизотропия $\gamma(H)$ будет отличаться от указанной на рис. 1. Таким образом, характер анизотропии $\gamma(H)$ позволит судить об ориентациях O_2 по отношению к молекулам углеводорода, предпочтительных для передачи энергии по обменно-резонансному механизму.

Как показано выше, численное значение k сильно влияет на величину эффекта. Это может привести к практической ненаблюдаемости эффекта для ряда соединений, в которых он принципиально возможен. Но в веществах, для которых $k \geq 1$, эффект должен наблюдаться, как это и имеет место в тетрадене.

Авторы признательны проф. Н. Д. Соколову за полезные дискуссии и ценные замечания.

Институт химической физики
Академии наук СССР
Москва

Поступило
7 XII 1971

ЦИТИРОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

- 1 Е. Л. Франкевич, И. А. Соколик, Письма ЖЭТФ, 14, № 11 (1971).
- 2 Т. М. Вембер, А. С. Черкасов, Теоретич. и эксп. хим., 7, № 3, 398 (1971).
- 3 Н. Kautsky, Trans. Farad. Soc., 35, 216 (1939); А. Н. Теренин, Фотоника молекул красителей, «Наука», 1967, стр. 309. ⁴ В. Л. Ермолаев, Сборн. Элементарные фотопроцессы в молекулах, «Наука», 1966, стр. 147. ⁵ R. C. Johnson, R. E. Merrifield, Phys. Rev., B1, 896 (1970). ⁶ A. Suna, Phys. Rev., B1, 1716 (1970).
- 7 D. Haarer, D. Schmid, H. C. Wolf, J. Phys. Status Solidi, 23, 633 (1967).
- 8 S. Foner, H. Meyer, W. H. Kleiner, J. Phys. Chem. Solids, 18, 273 (1964).
- 9 J. R. Roy, M. A. El-Sayed, J. Chem. Phys., 40, 3443 (1964).